



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HX1267

对应国外型号

KTA1267

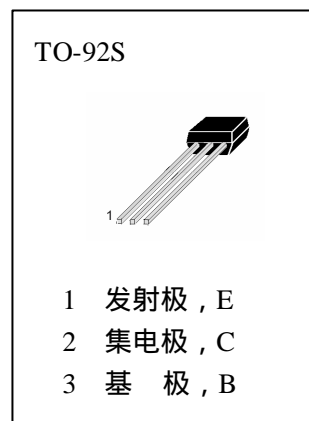
主要用途

开关应用。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	——贮存温度.....	-55~150
T_j	——结温.....	150
P_C	——集电极功率耗散 ($T_c=25$)	400mW
V_{CBO}	——集电极—基极电压.....	-50V
V_{CEO}	——集电极—发射极电压.....	-50V
V_{EBO}	——发射极—基极电压.....	-5V
I_C	——集电极电流.....	-150mA
I_E	——发射极电流.....	150mA

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I_{EBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{EB}=-5V, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—发射极饱和电流			-0.1	μA	$V_{CB}=-50V, I_E=0$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		-0.1	-0.3	V	$I_C=-100mA, I_B=-10mA$
h_{FE}	直流电流增益	70		400		$V_{CE}=-6V, I_C=-2mA$
f_T	特征频率	80			MHz	$V_{CE}=10V, I_C=-1mA$
C_{ob}	共基极输出电容		4.0	7.0	PF	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$
N_f	噪声系数		1.0	10	dB	$V_{CB}=-6V, I_C=-0.1mA, f=1kHz, R_g=10k$

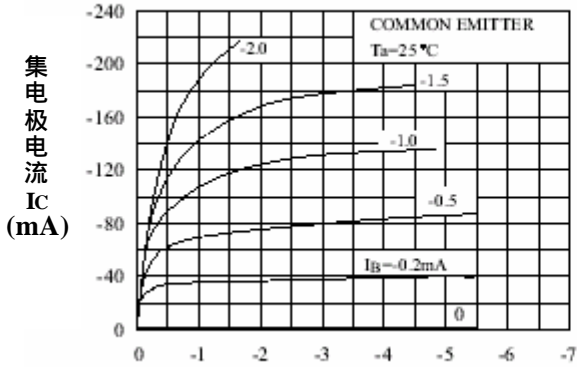
分档及其标志

O	Y	GR
70—140	120—240	200—400



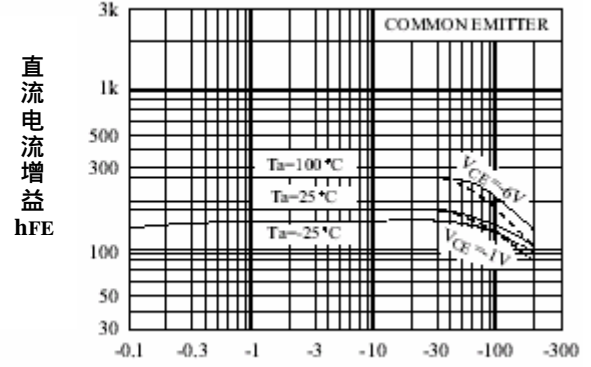
特性曲线

$I_C - V_{CE}$



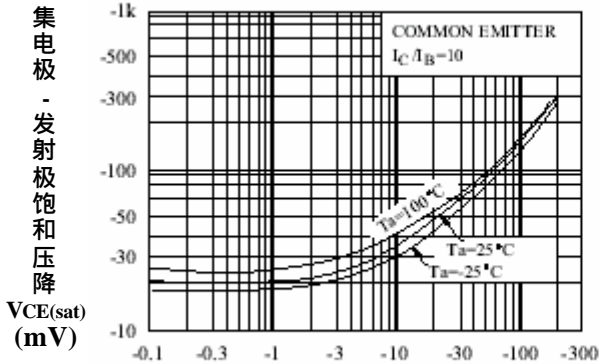
集电极-发射极电压 VCE(V)

$h_{FE} - I_C$



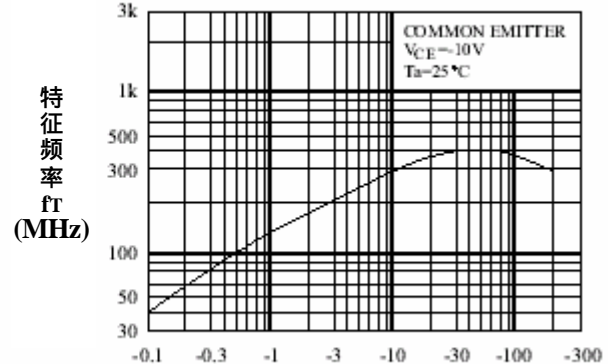
集电极电流 IC(mA)

$V_{CE(sat)} - I_C$



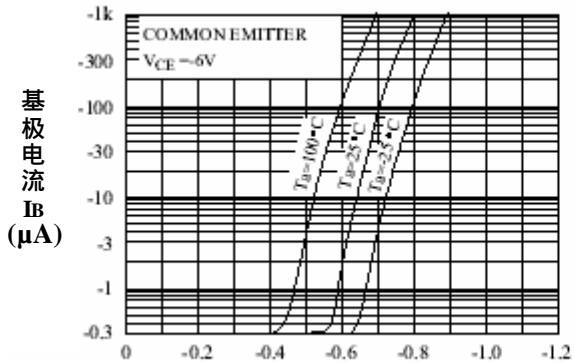
集电极电流 IC(mA)

$f_T - I_C$



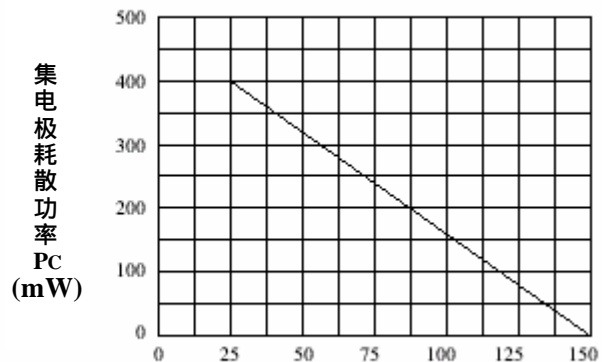
集电极电流 IC(mA)

$I_B - V_{BE}$



基极-集电极电压 VBE(V)

$P_c - T_a$



环境温度 Ta()

集电极耗散功率 PC (mW)